

[Go to Home Page](#)

半導体材料として、SiC は Si に対して3倍のバンドギャップ、10倍の絶縁破壊電界強度、3倍の熱伝導率を有します。
Si と比べて高耐圧化や低抵抗化、低損失化、高温動作化の点で優れているため、パワーデバイス用途として期待されています。

当社でも SiC デバイス開発に着手しており、2018年からの量産を目指しております。
同時に、化合物ラインのファンドリー（OEM）も進めており、ワイドバンドギャップ半導体（SiC、GaN、GaAs、Ga2O3、ダイヤモンド、etc. . . ）の
未来に貢献します。

